



①9 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 42 17 305 A 1**

⑤1 Int. Cl. 5:  
**H 03 K 17/00**  
G 01 F 23/22



**DEUTSCHES  
PATENTAMT**

②1 Aktenzeichen: P 42 17 305.1  
②2 Anmeldetag: 25. 5. 92  
④3 Offenlegungstag: 2. 12. 93

⑦1 Anmelder:

Eferl, Franc, Kamnica, Slovenia, SI; Zatler, Andrej,  
Maribor, Slovenia, SI

⑦4 Vertreter:

Eitle, W., Dipl.-Ing.; Hoffmann, K., Dipl.-Ing.  
Dr.rer.nat.; Lehn, W., Dipl.-Ing.; Fücksle, K.,  
Dipl.-Ing.; Hansen, B., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.;  
Brauns, H., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Görg, K.,  
Dipl.-Ing.; Kohlmann, K., Dipl.-Ing.; Ritter und Edler  
von Fischern, B., Dipl.-Ing.; Kolb, H., Dipl.-Chem.  
Dr.rer.nat., Pat.-Anwälte; Nette, A., Rechtsanw.,  
81925 München

⑦2 Erfinder:

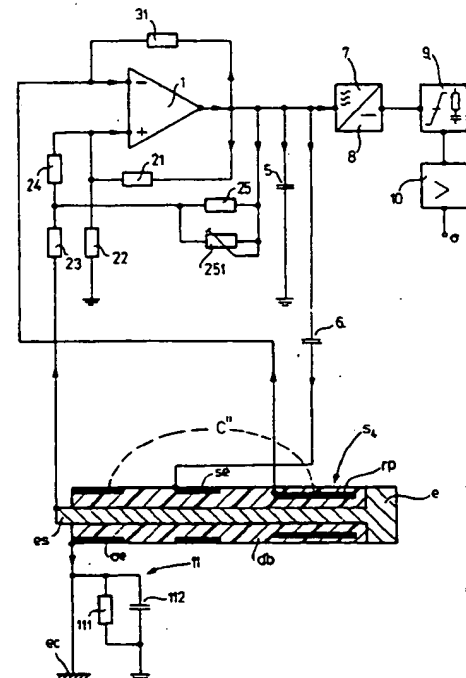
gleich Anmelder

⑤6 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit  
in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DE	27 51 864 C2
DE	29 32 051 A1
DE	27 20 006 A1
DD	28 25 515 A5
US	41 88 549
US	34 12 220

⑤4 Niveauschalter

⑤7 In dem Niveauschalter sind der invertierende Eingang eines positiv und negativ rückgekoppelten Operationsverstärkers 1 mit einer Ringplatte rp und sein nichtinvertierender Eingang mit einer Elektrode e und sein Ausgang über den Kondensator 5 mit Masse verbunden. Eine an Masse angeschlossene Gegenelektrode oe umgibt ein Ende eines dielektrischen Körpers db der Sonde  $s_k$ , in den nahe an dessen anderem Ende eine Ringplatte rp coaxial eingebaut ist, und am Umfang des Körpers db zwischen der Gegenelektrode oe und der Ringplatte rp ist eine Schirmelektrode se angeordnet, die über einen Kondensator 6 an den Ausgang des Operationsverstärkers 1 angeschlossen ist. Das andere Ende des Körpers db ist durch die Elektrode e abgeschlossen. Der Ausgang des Operationsverstärkers 1 ist seriengeschaltet über ein frequenztaufes Bandfilter 7, einen Gleichrichter 8, einen Amplitudenbegrenzer 9 und einen Verstärker 10 an den Ausgang o des Niveauschalters angeschlossen.



**E 42 17 305 A 1**

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Niveauschalter, mit dem wahrgenommen wird, daß die Oberfläche eines in einem Behälter enthaltenen Materiales das Niveau der dem Niveauschalter zugehörenden Sonde erreicht hat.

Derartige Niveauschalter werden z. B. in Silos, Sammelbehältern oder in Sammelbecken verwendet, die offen oder geschlossen, unter Luftdruck, veränderlichem oder stetigem Druck sein können. Darin enthaltene Materialien können sehr verschieden sein: flüssige, körnige oder pulverige Materialien verschiedener Dichte, Zähigkeit und Anhaftigkeit, rein oder vermischt mit festen Teilchen verschiedener Größen, mit Luftbläschen, mit einem Schaum auf der Oberfläche, homogen oder inhomogen, mit stetigen oder veränderlichen elektrischen Eigenschaften. Der Anwendungsbereich eines Niveauschalters nach dem Stand der Technik ist beschränkt und in der Regel muß der Niveauschalter auf das Material im Behälter abgeglichen werden.

Das Niveauiwahrnehmen beruht auf verschiedenen Grundlagen. Man kennt mechanische, elektromechanische, hydrostatische Niveauschalter, Ultraschall-Niveauschalter, kapazitive, konduktive Niveauschalter, Mikrowellen-Niveauschalter, optische und auf der Radiometrie beruhende Niveauschalter.

Mechanische oder elektromechanische Niveauschalter sind nur für Flüssigkeiten geeignet. Wegen des Schwimmers und des Übertragungsgestänges sind sie jedoch gegen Beläge, feste Teilchen in der Flüssigkeit, Turbulenzen und Schäume an der Oberfläche empfindlich.

Kapazitive Niveauschalter sind universaler. Die Kapazität des Meßkondensators der Sonde ändert sich mit der Verschiebung des Niveaus eines im Behälter enthaltenen Materiales wegen des von 1 abweichenden Wertes der Dielektrizitätskonstante des Materiales.

Es ist eine kapazitive Sonde mit der Schaltung (FTC 968, beschrieben in dem Handbuch für Ingenieure; Sensoren, Meßaufnehmer, Neue Verfahren und Produkte für die Praxis, 2. Ausgabe, S. 521 bis 529, Expert Verlag, Ehningen bei Boblingen (1988)) zum Wahrnehmen des Füllstandes eines Behälters mit einem feinkörnigen Schüttgut (Korngröße bis zu 10 mm) bekannt, dessen Dielektrizitätskonstante den Wert 1,6 übersteigt. Die Sonde ist derweise entworfen, daß der störende Einfluß des an der Sonde haftenden Materialbelags selbsttätig behoben wird. Die Sonde ist aus einem hohlen und an einem Ende geschlossenen Kunststoffzylinder hergestellt, in dessen Inneren an der Basis und auch teilweise am Mantel eine Meßelektrode gefertigt ist. An der Innenwand des Zylindermantels der Sonde sind ferner noch eine Schirmelektrode und eine an Masse angeschlossene Abschlußbringelektrode angeordnet. Die Schaltung mit einem Multivibrator mit der konstanten Frequenz 0,5 kHz stellt auf der Schirmelektrode ein Potential her, das sich mit einer Phasenverzögerung gegenüber dem Potential an der Meßelektrode ändert. Damit erreicht man, daß die Schirmelektrode die zwischen der Meßelektrode und der Abschlußbringelektrode verlaufenden Feldlinien hinausschiebt. Die Feldlinien ragen darum aus dem Materialbelag an der Sonde. Der beschriebene Niveauschalter ist für ein trockenes, nicht aber für ein elektrisch leitendes feuchtes Schüttgut geeignet.

Es ist ferner auch ein kapazitiver Niveauschalter (Typ 23 und 25 der Firma VEGA, BRD) bekannt, der auch für elektrisch leitende und stark anhaftende Materialien ge-

eignet ist. Eine vollkommen isolierte Stabsonde umfaßt eine Schutzschirmelektrode, die den Einfluß der Schicht des anhaftenden Materiales kompensiert. Die Schutzschirmelektrode leitet den unerwünschten, durch diese Schicht von der Sondenspitze zum Befestigungsstück fließenden elektrischen Strom ab.

Alle bekannte kapazitive Niveauschalter müssen auf das in dem Behälter enthaltene Material abgeglichen werden und ihre Anzeigen sind nicht mehr zutreffend, sobald sich die Materialparameter ändern. Ebenso ist kein Niveauschalter bekannt, der ohne einen vorherigen Abgleich den Wechsel von einem elektrisch leitenden auf ein elektrisch nicht leitendes Material, von einem anhaftenden auf ein nicht anhaftendes Material u. ä. bewältigen könnte. Während also durch bekannte Niveauschalter die Aufgabe, die Senkung eines der Sonde des Niveauschalters nicht anhaftenden Materials mit einer elektrischen Leitfähigkeit unter 0,1 mS/cm wahrzunehmen, noch lösbar ist, ist das für ein anhaftendes Material mit keinem bekannten Niveauschalter, weder mit einem kapazitiven noch mit einem konduktiven, durchführbar. In solchem Extremfall verwendet man ein Ultraschall- oder ein auf der Radiometrie beruhendes Füllstandmeßgerät, das jedoch eine teure und anspruchsvolle, aber auch entwerfsmäßig oder sonst nicht immer durchführbare Lösung ist.

Bekannte konduktive Niveauschalter sind für Materialien mit der elektrischen Leitfähigkeit über 3  $\mu$ S/cm geeignet und müssen auf jeweiliges in dem Gefäß vorhandenes Material abgeglichen werden. Es wird eine Sonde mit voneinander entfernten und von dem in dem Behälter vorhandenen Material umgebenen Elektroden verwendet, von denen eine an einen Oszillator mit einer konstanten Frequenz von 3 kHz und 4 kHz angeschlossen ist. Der Oszillator speist eine Brückenschaltung, in deren einem Brückenarm die Sonde des Niveauschalters und in dem anderen ein Potentiometer zum Abgleichen an das in dem Behälter enthaltene Material geschaltet sind. Das Signal von der Brückenschaltung wird in einen Vergleichler und danach über ein die Störsignale unterdrückendes Filter in einen Ausgangsverstärker geleitet. Der elektrische Widerstand des zwischen den Sondenelektroden sich befindenden Materiales kann aber als ein weiter an einen Vergleichler vermittelter Spannungsabfall an einem konstanten in der Schaltung enthaltenen Widerstand wiedergegeben werden. In dem Vergleichler wird der Arbeitspunkt für die Umschaltung eingestellt.

Es ist ein Niveauschalter (VEGATOR 261 A der Firma VEGA, BRD) bekannt, der als einziger unter den Niveauschaltern dieser Art beim Wechsel des in dem Behälter enthaltenen Materiales keinen Abgleich braucht. Die Sonde ist mit drei voneinander getrennten und mit einem Oszillator konstanter Frequenz 4 kHz verbundenen Ringelektroden unterschiedlicher Oberflächen versehen. Die Ausgewogenheit der Widerstände des Materiales unter den Elektroden ermöglicht, daß der Niveauschalter in Materialien mit einer niedrigen elektrischen Leitfähigkeit zwischen 1  $\mu$ S/cm und 15  $\mu$ S/cm funktionieren kann. Dieser Niveauschalter ist jedoch nicht für Materialien sehr niedriger elektrischer Leitfähigkeit, z. B. destilliertes Wasser, geeignet.

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, einen Niveauschalter zu schaffen, mit dem eine Senkung der Oberfläche von Materialien mit verschiedensten Eigenschaften, das heißt eines flüssigen, körnigen oder pulverigen sowie eines elektrisch leitenden und nicht leitenden und auch eines anhaftenden und nicht anhaftenden Ma-

terials, unter das Niveau der dem Niveauschalter zugehörenden Sonde anhand der Höhe der Frequenz des in der Schaltung des erfindungsgemäßen Niveauschalters erzeugten Signals wahrgenommen wird, wobei bei dem Wechsel von einem in dem Behälter enthaltenen Material zum anderen Material nicht jedesmal eigens eine Abgleichung des Niveauschalters erforderlich sein wird.

Die genannte Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im Kennzeichen des Anspruchs 1, 2, 3 oder 4 angegebenen Merkmale gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen 5 und 6 angegeben.

Ein Vorteil aller durch die Erfindung vorgeschlagenen Ausführungsbeispiele des Niveauschalters liegt vor allem darin, daß der Niveauschalter nicht jedesmal eigens abgeglichen zu werden braucht, wenn das Material in dem Behälter gewechselt wird, auch wenn es sich um Materialien sehr verschiedener Eigenschaften handeln sollte, und zwar elektrisch leitende sowie elektrisch nicht leitende, anhaftende sowie nicht anhaftende, flüssige, pulverige, körnige, teigartige oder breiartige Materialien. Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Niveauschalters besteht auch darin, daß seine elektronische Schaltung einfach und aus wenigen Elementen zusammengebaut ist.

Die Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden im folgenden näher beschrieben.

Es zeigen:

Fig. 1 einen konduktiven Niveauschalter als das erste Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Niveauschalters,

Fig. 2 einen kapazitiven Niveauschalter in der Grundausführung als das zweite Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Niveauschalters,

Fig. 3 einen kapazitiven Niveauschalter in einer weiteren Ausführung als das dritte Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Niveauschalters,

Fig. 4 einen kombinierten Niveauschalter als das vierte Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Niveauschalters.

In allen vier Ausführungsbeispielen ist der Niveauschalter mit einer Sonde  $s_j$  ( $j = 1$  bis 4) und mit einer dazugehörenden Schaltung (Fig. 1, 2, 3 und 4) dargestellt, an deren Ausgang ein Relais und/oder eine Alarmanlage angeschlossen sind (nicht dargestellt). Dabei ist die Sonde  $s_j$  jedesmal aus einem zylindrischen dielektrischen Körper  $db$  gefertigt und mit einer ringartigen Gegenelektrode  $oe$  versehen, die in der Umfangsrichtung ein Ende des dielektrischen Körpers  $db$  umgibt und an Masse beziehungsweise in der praktischen Anwendung an den ein Material enthaltenden Behälter angeschlossen ist. In allen Ausführungsbeispielen des erfindungsgemäßen Niveauschalters ist ein Operationsverstärker 1 durch Widerstände 21, 31 positiv beziehungsweise negativ rückgekoppelt und zusammen mit der Sonde  $s_j$  bildet er einen Oszillator. Die Frequenz des Oszillators hängt von den physikalischen Verhältnissen um die Sonde  $s_j$  ab, doch die Ausgangsspannung des Oszillators ist stetig und wird vorteilhaft als Sättigungsspannung des verwendeten Operationsverstärkers 1 gewählt. Der Ausgang des Operationsverstärkers 1, dessen Speisung auf eine an sich bekannte Weise ausgeführt ist, ist direkt oder indirekt an den Eingang einer Formschaltung angeschlossen, deren Ausgang auch den Ausgang  $o$  des Niveauschalters darstellt. Die Formschaltung besteht aus in Serie geschalteten einem frequenz tiefen Bandfilter 7, einem Gleichrichter 8, einem wesentlich aus einer Zener-Diode und einem Kondensa-

tor bestehenden Amplitudenbegrenzer 9, von dem übriggebliebene Spitzen unterdrückt werden, und einem Verstärker 10.

Der erfindungsgemäße Niveauschalter ist in dem ersten Ausführungsbeispiel als ein konduktiver Niveauschalter ausgeführt (Fig. 1). Der zylindrische dielektrische Körper  $db$  der Sonde  $s_1$  ist an seinem freien Ende durch eine Elektrode  $e$  abgeschlossen. Ein Schaft  $es$  der Elektrode  $e$  durchdringt den dielektrischen Körper  $db$  axial und ragt an dem anderen Ende des dielektrischen Körpers  $db$  daraus. Der Elektrodeschaft  $es$  und damit die Elektrode  $e$  ist über einen Widerstand 23 an den nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers 1 angeschlossen, dessen invertierender Eingang über einen Kondensator 32 an Schaltungsmasse angeschlossen ist. Der Ausgang des Operationsverstärkers 1 ist über einen als Hochfrequenzfilter funktionierenden Kondensator 4 an den Eingang des frequenz tiefen Bandfilters 7 angeschlossen.

Die elektrische Spannung an dem nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers 1 hängt von dem Widerstand  $es$  zwischen den Elektroden  $e$ ,  $oe$  befindenden Materials ab, denn der Operationsverstärker 1 ist über den Widerstand 23, über die Elektrode  $e$ , das Material zwischen den Elektroden  $e$  und  $oe$  und über die Elektrode  $oe$  mit Masse verbunden. Diese Spannung beeinflusst jedoch die Geschwindigkeit der Ladung beziehungsweise der Entladung des Kondensators 32 über einen Widerstand 31. Auf diese Weise wird die Oszillatorfrequenz durch die elektrische Leitfähigkeit und Verteilung des Materials um die Sonde  $s_1$  bestimmt.

Die Parameter der passiven Elemente im Oszillator, also auch die Oberfläche der Elektroden  $e$ ,  $oe$  und ihr gegenseitiger Abstand werden aufgrund der Voraussetzung einer Gleichheit der Wechselstrom-Signalamplituden an den Elektroden  $e$ ,  $oe$  in beiden Halbperioden bestimmt, d. h. es soll der Einfluß galvanischer Erscheinungen unterdrückt werden. Nun wird die Oszillatorfrequenz auf den Wert um 3 kHz für die Materialien mit einer hohen elektrischen Leitfähigkeit um 0,1 S/cm und auf den Wert um 300 Hz für die Materialien mit einer niedrigen elektrischen Leitfähigkeit um 10  $\mu$ S/cm eingestellt. Diese Beziehungen sind dem Fachmann bekannt und werden durch komplexe Erscheinungen bei dem Übergang des elektrischen Stromes zwischen zwei Elektroden erklärt, wo eine frequenzabhängige Phasenverschiebung zwischen dem Strom und der Spannung entsteht.

Es ist daher günstig den Widerstand 31 und den Kondensator 32 so zu bestimmen, daß an dem Ausgang des Operationsverstärkers immer die Sättigungsspannung erreicht wird. Das wurde z. B. für Materialien mit der elektrischen Leitfähigkeit in den Grenzen zwischen 10  $\mu$ S/cm und 0,1 S/cm erreicht. Durch Ändern der Passiv Elemente des Oszillators kann die untere Grenze des Leitfähigkeitsintervalls der Materialien bis zur elektrischen Leitfähigkeit des destillierten Wassers gesenkt werden, d. h. bis zu 2  $\mu$ S/cm. In dem Fall wird aber auch die obere Grenze des Intervalls auf 0,01 S/cm gesenkt.

Wenn jedoch die Oberfläche des anhaftenden Materials unter das Niveau der Sonde  $s_1$  des konduktiven Niveauschalters absinkt, bleibt auf der Sonde  $s_j$  ein dünner Materialbelag. Der Ohmwert und die Induktivität dieser Schicht für den Wechselstrom zwischen den Elektroden  $e$  und  $oe$  steigen und die Oszillatorfrequenz sinkt. Der Kondensator 4 läßt nun nur wenig elektrischen Strom durch, was stark an die Spannung an dem Ausgang  $o$  einwirkt. Bei gering anhaftenden Materialien

wird der Kondensator 4 mit gleicher Kapazität für elektrisch gut oder schlecht leitende Materialien verwendet. Doch muß man bei elektrisch gut leitenden Materialien mit einer Leitfähigkeit zwischen 1 mS/cm und 100 mS/cm die Kapazität des Kondensators 4 soweit herabsetzen, daß das Signal stark unterdrückt sein wird, wie das Material so stark anhaftet, daß an der Sonde  $s_1$  ein starker Belag bleibt, wenn sich die Oberfläche des Materials unter das Niveau der Sonde  $s_1$  zurückzieht.

Der konduktive Niveauschalter als das erste Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Niveauschalters arbeitet also mit einer konstanten Spannungsamplitude an dem Ausgang des Oszillators, doch ändert sich die Frequenz des Oszillators, wenn die Oberfläche des in dem Behälter enthaltenen Materials unter das Niveau der Sonde  $s_1$  absinkt. Das Verhalten des Niveauschalters wird daher schlicht durch die Kapazität des Kondensators 4 eingestellt. Mit derselben elektronischen Schaltung deckt man Materialien mit der elektrischen Leitfähigkeit zwischen 10  $\mu$ S/cm und 0,1 S/cm, d. h. alle in der Industrie und sonst technisch interessante Materialien.

Der Niveauschalter nach der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß er nicht auf das in einem Behälter enthaltene Material abgeglichen zu werden braucht und zuverlässig ist. Die hervorragende Zuverlässigkeit des Niveauschalters kommt besonders zum Ausdruck, wenn er vor einer vollkommenen Ausleerung oder vor einer Knappheit des in dem Behälter enthaltenen Materials schützen soll.

Der Niveauschalter nach der Erfindung ist in dem zweiten Ausführungsbeispiel als ein kapazitiver Niveauschalter in der Grundauführung ausgeführt (Fig. 2). In dem zylindrischen dielektrischen Körper db der Sonde  $s_2$  ist an seinem freien Ende koaxial eine Ringplatte rp eingebaut, die an den invertierenden Eingang des Operationsverstärkers 1 angeschlossen ist. Die Ringplatte rp ist also durch die dielektrische Schicht des dielektrischen Körpers db von dem in dem Behälter enthaltenen und die Sonde  $s_2$  umgebenden Material getrennt.

In dem zweiten wie auch in dem dritten und vierten Ausführungsbeispiel des Niveauschalters nach der Erfindung ist der an Masse angeschlossene Widerstand 22 mit seiner zweiten Klemme an den nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers 1 angeschlossen, dessen Ausgang über einen Kondensator 5 an Masse angeschlossen ist.

Die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers 1 bewirkt die Aufladung und die Entladung eines zwischen der Ringplatte rp und der Gegenelektrode oe aufgebauten und über den Widerstand 31 in der negativen Rückkopplung geschalteten virtuellen Kondensators C. Die Entladungs- beziehungsweise Aufladungsgeschwindigkeit des Kondensators C hängt natürlich von der Kapazität des Kondensators C ab, d. h. von der Dielektrizitätskonstante, der elektrischen Leitfähigkeit und der Verteilung des Materials, das den dielektrischen Körper db der Sonde  $s_2$  in dem Raum umgibt, in dem die Feldlinien zwischen der Ringplatte rp und der Gegenelektrode oe verlaufen, sowie von der Spannung an dem invertierenden Eingang des Operationsverstärkers 1. Diese Spannung kann jedoch in bezug auf die Spannung an dem Ausgang des Operationsverstärkers 1 durch ein geeignetes Verhältnis der Widerstände 21, 22 eingestellt werden. Bei den gewählten Parametern der passiven Elemente in dem kapazitiven Niveauschalter ist demnach die Oszillatorfrequenz nur von Eigenschaften und von der Verteilung des Materials um die Sonde  $s_2$  ab-

hängig. Bei der Ausführung der eigentlichen Sonde  $s_2$  wird jedoch die Oszillatorfrequenz durch die Oberflächen und die Durchmesser der ringartigen Gegenelektrode oe und der Ringplatte rp, durch ihren Längsabstand sowie durch die Dielektrizitätskonstante des zylindrischen dielektrischen Körpers db bestimmt.

Die Forderung nach der Amplitudengleichheit des Wechselstromsignals in beiden Halbperioden wird bei dem kapazitiven Niveauschalter nicht so streng gestellt wie bei dem konduktiven Niveauschalter gestellt. Die Parameter der passiven Oszillatorelemente werden bestimmt, daß die Amplitude der Ausgangsspannung des Operationsverstärkers 1 den Sättigungspunkt erreicht.

Der kapazitive Niveauschalter in der Grundauführung nach der Erfindung funktioniert im Falle eines elektrisch gut leitenden in dem Behälter enthaltenen Materials folgendermaßen. Wegen der guten elektrischen Leitfähigkeit bewegt sich die Gegenelektrode oe scheinbar in Richtung zu der Ringplatte rp, wodurch die Kapazität des Kondensators C steigt, und zwar desto mehr je höher die elektrische Leitfähigkeit des Materials ist. Sobald also die Sonde  $s_2$  mit dem elektrisch leitenden Material umgeben wird, sinkt die Oszillatorfrequenz ab, und zwar mehr bei einer hohen elektrischen Leitfähigkeit, z. B. 0,1 S/cm, und weniger bei einer niedrigeren elektrischen Leitfähigkeit, z. B. 2  $\mu$ S/cm. Wenn aber die Materialoberfläche unter das Niveau der Sonde  $s_2$  absinkt, bleibt das Material an der Sonde  $s_2$  als ein dünner Belag haften. Dadurch fällt die Kapazität des Kondensators C ab und die Oszillatorfrequenz steigt an. Der Kondensator 5 leitet jedoch das Hochfrequenzsignal an dem Ausgang des Operationsverstärkers 1 an Masse ab. Der Kondensator 5 wirkt demnach als ein Niederfrequenzfilter. Im Falle eines elektrisch schwach leitenden und stark anhaftenden Materials wählt man eine höhere Kapazität des Kondensators 5.

Der kapazitive Niveauschalter der beschriebenen Ausführung ist jedoch auch für elektrisch nicht leitende Materialien sehr gut geeignet. Da die Dielektrizitätskonstante des Materials jedenfalls den Wert 1 übersteigt, spiegelt sich nun die Materialanwesenheit, im Vergleich zur Situation, wenn die Materialoberfläche unter das Niveau der Sonde  $s_2$  absinkt, bloß an der Erhöhung der Kapazität des Kondensators C und damit an der Absenkung der Oszillatorfrequenz.

Der kapazitive Niveauschalter in der Grundauführung nach der Erfindung ist besonders für nicht anhaftende Materialien mit der elektrischen Leitfähigkeit zwischen 0,2  $\mu$ S/cm und 1 mS/cm gut geeignet.

Ein Vorteil gegenüber den bekannten kapazitiven Niveauschaltern liegt darin, daß sich die Oszillatorfrequenz bei einem Wechseln der Materialien mit verschiedenen elektrischen Leitfähigkeiten beziehungsweise Dielektrizitätskonstanten selbsttätig einstellt, wobei jedoch kein Potentiometer zum Abgleich des Niveauschalters auf ein neues Material gebraucht wird.

Der Niveauschalter in dem dritten Ausführungsbeispiel nach der Erfindung ist als eine weitere Ausführungsform des kapazitiven Niveauschalters ausgeführt (Fig. 3). Die Sonde  $s_3$  und die dazugehörige Schaltung sind gegenüber denen bei dem Niveauschalter nach Fig. 2 folgenderweise ergänzt. Auf dem Umfang des zylindrischen dielektrischen Körpers db der Sonde  $s_3$  ist zwischen der Gegenelektrode oe und der Ringplatte rp eine Schirmelektrode se ausgeführt, die über den Kondensator 6 an den Ausgang des Operationsverstärkers 1 angeschlossen ist.

Bei der Beschreibung des Funktionierens des dritten

Ausführungsbeispielen des Niveauschalters gehen wir von dem Funktionieren des Niveauschalters nach Fig. 2 aus. Betrachten wir einen schwierigen Fall eines elektrisch gut leitenden anhaftenden Materiales. Wenn die Oberfläche des Materiales unter das Niveau der Sonde  $s_3$  absinkt, wird durch den zwischen der Gegenelektrode  $oe$  und der Schirmelektrode  $se$  an dem dielektrischen Körper  $db$  anhaftenden Belag elektrischer Kontakt von dem Ausgang des Operationsverstärkers 1 über den als frequenztaufes Bandfilter wirkenden Kondensator 6, über die Schirmelektrode  $se$  und über die Gegenelektrode  $oe$  zur Masse hergestellt und dadurch wird die Spannungsamplitude an dem Ausgang des Operationsverstärkers 1 kleiner. Dazu verschiebt sich noch die Schirmelektrode  $se$  scheinbar gegen die Ringplatte  $rp$  und dazwischen bildet sich ein virtueller Kondensator  $C'$ , dessen Kapazität niedrig ist, da sein Wirkungsraum auf den Materialbelag um die Sonde  $s_3$  begrenzt ist. Die Oszillatorfrequenz ist darum hoch und eine der Platten seines Kondensators  $C'$ , nämlich das ist die Schirmelektrode  $se$ , ist darum über den Kondensator 6 an den Ausgang des Operationsverstärkers 1 gebracht. Außerdem ist die Ringplatte  $rp$  des Kondensators  $C'$  über den Widerstand 31 an den Ausgang des Operationsverstärkers 1 angeschlossen. Kurzum, die Kapazität des Kondensators  $C'$  ist gering. Darum ist die Oszillatorfrequenz sehr hoch und das Hochfrequenzsignal wird durch den Kondensator 5 an Schaltungsmasse abgeleitet. Das zum Ausgang  $o$  des Niveauschalters angelangte Signal ist im Unterschied zum Signal in der Situation, wenn die Materialoberfläche das Niveau der Sonde  $s_3$  übersteigt, sehr schwach. In jener Situation ist die Oszillatorfrequenz niedriger, denn die Kapazität des Kondensators  $C'$  ist größer wegen seines weiter reichenden Wirkungsraumes in dem Material.

Durch die Schirmelektrode  $se$  steigt die Leistungsfähigkeit des Niveauschalters nach Fig. 3 im Vergleich zum Niveauschalter in Fig. 2, weil er auch für elektrisch gut leitende Materiale, die aber zugleich auch stark an dem dielektrischen Körper  $db$  der Sonde  $s_3$  haften bleiben, geeignet ist. Der kapazitive Niveauschalter in dem dritten Ausführungsbeispiel nach der Erfindung übertrifft alle bis jetzt bekannte Niveauschalter in Hinsicht auf die Mannigfaltigkeit der Materiale in seinem Anwendungsbereich.

Der Niveauschalter nach der Erfindung ist in dem vierten Ausführungsbeispiel als ein kombinierter konduktiv-kapazitiver Niveauschalter ausgeführt (Fig. 4). Die Sonde  $s_4$  umfaßt eine Elektrode  $e$ , die Gegenelektrode  $oe$ , eine Schirmelektrode  $se$  und eine Ringplatte  $rp$ , die alle an dem zylindrischen dielektrischen Körper  $db$  montiert sind. Dabei umgibt die ringartige Gegenelektrode  $oe$  ein Ende des dielektrischen Körpers  $db$ , und nahe am anderen Ende des mit der Elektrode  $e$  abgeschlossenen dielektrischen Körpers  $db$  ist darin die Ringplatte  $rp$  coaxial eingebaut. Am Umfang des dielektrischen Körpers  $db$  ist zwischen der Gegenelektrode  $oe$  und der Ringplatte  $rp$  die Schirmelektrode  $se$  angebracht. Der metallene Schaft  $es$  der Elektrode  $e$  dringt axial durch den dielektrischen Körper  $db$  hindurch und ragt an dem anderen Ende des dielektrischen Körpers  $db$  hinaus.

In der Schaltung des vierten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Niveauschalters ist der invertierende Eingang eines Operationsverstärkers 1, bei dem die positive und die negative Rückkopplung durch einen Widerstand 21 beziehungsweise durch einen Widerstand 31 realisiert sind, an die Ringplatte  $rp$  der Son-

de  $s_4$  angeschlossen und der nichtinvertierende Eingang des Operationsverstärkers 1 ist über seriengeschaltete Widerstände 23, 24 an das freie Ende des Schaftes  $es$  der Elektrode  $e$  angeschlossen. Die Schirmelektrode  $se$  ist über den Kondensator 6 an den Ausgang des Operationsverstärkers 1 angeschlossen. Der Ausgang des Operationsverstärkers 1 ist über einen Widerstand 25 und einen dazu parallel geschalteten regelbaren Widerstand 251 an die gemeinsame Klemme der Widerstände 23, 24 angeschlossen. Der Masse angeschlossene Widerstand 22 ist mit seiner zweiten Klemme an den nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers 1 angeschlossen, dessen Ausgang über den Kondensator 5 mit Masse verbunden ist. Der Ausgang des Operationsverstärkers 1 ist über hintereinander verbundene ein frequenztaufes Bandfilter 7, einen Gleichrichter 8, einen Amplitudenbegrenzer 9 und einen Verstärker 10 mit dem Ausgang  $o$  des Niveauschalters verbunden. Die ringartige Gegenelektrode  $oe$  ist bei der Anwendung in elektrisch sehr gut leitenden Materialien mit der Leitfähigkeit zwischen 0,1 S/cm und 1 S/cm und sogar höher, um eine Verformung der Spannungsamplitude an der Sonde  $s_4$  zu vermeiden, an die Erde  $ec$  des elektrischen Netzes und über ein aus einem Widerstand 111 und einen parallel dazu geschalteten Kondensator 112 zusammengesetzten Filter 11 noch an Masse der Schaltung angeschlossen.

Mit dem regulierbaren Widerstand 251 stellt man Niveauschalter mit unterschiedlich großen Sonden  $s_4$  auf das gleiche Verhalten ein.

Die Schirmelektrode  $se$  wirkt sowohl auf den konduktiven als auch auf den kapazitiven Teil des kombinierten Niveauschalters, wobei beide Wirkungen auf eine komplexe Weise verflochten sind. In dem konduktiven Teil stellt sich die von der elektrischen Leitfähigkeit des Materials abhängige positive Rückkopplung von dem Ausgang des Operationsverstärkers 1 über den Kondensator 6 und über das Material zwischen der Schirmelektrode  $se$  und der Elektrode  $e$  zurück an den nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers 1 ein. Die Schirmelektrode  $se$  wirkt über das die Sonde  $s_4$  umgebende Material auch als ein Spannungsteiler zwischen der Gegenelektrode  $oe$  und der Elektrode  $e$  und übt dadurch eine Wirkung auf die Spannung an dem nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers 1 aus. In dem kapazitiven Teil wirkt sie jedoch auf die Bildung eines virtuellen Kondensators  $C''$  ein, dessen Platten die Ringplatte  $rp$  und die Gegenelektrode  $oe$  sind. Indem die Schirmelektrode  $se$  mit dem Ausgang des Operationsverstärkers 1 verbunden ist, wird die Kapazität des Kondensators  $C''$  herabgestellt. Dadurch wird eine zu niedrige Oszillatorfrequenz, besonders bei elektrisch sehr gut leitenden Materialien, vermieden. Die Kapazität des Kondensators  $C''$  wird jedoch auch von der Gegenelektrode  $oe$  auf die gleiche Weise beeinflusst. Die Gegenelektrode  $oe$  ist einerseits mit dem nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers 1 verbunden, andererseits hat sie aber einen über das elektrisch gut leitende Material hergestellten Kontakt zu der Schirmelektrode  $se$ .

Auf diese Überlegungen stützen wir uns bei der Beschreibung des Funktionierens des kombinierten Niveauschalters nach der Erfindung. Setzen wir zunächst voraus, daß die Sonde  $s_4$  in ein Material, das an der Sonde  $s_4$  gut haftet und elektrisch gut leitend ist, z. B. in einen Salzteig, eingetaucht wird. Der Oszillator in der Schaltung des Niveauschalters reagiert auf ein solches Material folgendermaßen. Das elektrisch gut leitende

Material rückt die Ringplatte  $rp$  und die Gegenelektrode  $oe$ , die den virtuellen Kondensator  $C''$  bilden, scheinbar näher zusammen. Der Kondensator  $C''$  ist an den invertierenden Eingang des Operationsverstärkers 1 angeschlossen. Sein nichtinvertierender Eingang ist über das Material zwischen der Elektrode  $e$  und der Gegenelektrode  $oe$  mit Masse verbunden. Zugleich ist die Elektrode  $e$  mit dem anderen Eingang des Operationsverstärkers 1 als die Ringplatte  $rp$  verbunden und vermindert dadurch die Kapazität des Kondensators  $C''$ . Die Schirmelektrode  $se$  wirkt einerseits als eine zusätzliche Rückkopplung, andererseits aber wirkt sie in Abhängigkeit von der elektrischen Leitfähigkeit als Spannungsteiler und beeinflusst die Spannung an dem nichtinvertierenden Eingang. Die Oszillatorfrequenz ist den genannten regulierenden Einflüssen unterworfen, die von der Anwesenheit des Materiales herrühren. Wenn aber die Materialoberfläche unter das Niveau der Sonde  $s_4$  absinkt, reagiert der erfindungsgemäße Niveauschalter unabhängig davon, ob teilweise das elektrisch gut leitende Material zum Teil haftend an der Sonde  $s_4$  zurückgeblieben ist. Der Belag aus dem elektrisch gut leitenden Material verhilft auf die oben beschriebene Weise zum Erscheinen des virtuellen Kondensators  $C''$ , dessen Kapazität jedoch stark durch die Elektrode  $e$  und die Gegenelektrode  $oe$  herabgesetzt wird. Die Schirmelektrode  $se$  liegt nämlich räumlich gesehen zwischen der Ringplatte  $rp$  und der Gegenelektrode  $oe$ , während die Elektrode  $e$  und die Schirmelektrode  $se$  mit dem Eingang beziehungsweise mit dem Ausgang des rückgekoppelten Operationsverstärkers 1 verbunden sind. Vor allem ist die Dicke des Materialbelages an der Sonde  $s_4$  sehr begrenzt, die Entstehung des Kondensators  $C''$  ist aber an Schichten beschränkt, deren Dicke einen Kleinstwert überschreitet. Wenn der Kondensator  $C''$  verschwindet, hört der Oszillator zu funktionieren auf, was von der dem Operationsverstärker 1 nachgeschalteten Formschaltung wahrgenommen wird, und das zeigt sich am Signal an dem Ausgang  $o$  des kombinierten Niveauschalters nach der Erfindung. Wenn aber doch die Dicke des Materialbelags groß genug ist, daß sich der Kondensator  $C''$  bilden kann, ist seine Kapazität niedrig und demnach die Oszillatorfrequenz hoch, schätzungsweise über 20 kHz. Dieses Signal wird über den Kondensator 6, die Schirmelektrode  $se$  und den Materialbelag zwischen der Schirmelektrode  $se$  und der Gegenelektrode  $oe$  an Masse abgeleitet.

Es folgt daraus, daß für ein gutes Funktionieren des kombinierten Niveauschalters nach der Erfindung in ganz beliebigen Verhältnissen eine sorgfältige Berechnung der Schaltungselemente und der Sonde  $s_4$  nötig ist. So muß man sorgfältig die Abstände der Elektroden  $oe$ ,  $se$ ,  $e$  und der Ringplatte  $rp$  voneinander und den Durchmesser der Ringplatte  $rp$  bestimmen, damit die Schirmelektrode  $se$  nicht die Entstehung des Kondensators  $C''$  verhindern würde. Es ist auch die Qualität des dielektrischen Körpers  $db$  bildenden Dielektrikums wichtig. Der Durchmesser des Schaftes  $es$  hat Auswirkung auf seine Parasitkapazität zur Ringplatte  $rp$ . Wir haben festgestellt, daß die Oszillatorfrequenz, wenn die Materialoberfläche unter dem Niveau der Sonde  $s_4$  liegt, zwischen 1 kHz und 20 kHz liegt, wobei die elektrische Leitfähigkeit des Materiales zwischen 10 pS/cm und 1 S/cm lag; der kombinierte Niveauschalter funktioniert daher zuverlässig für elektrisch nicht leitende wie auch für elektrisch sehr gut leitende Materialien.

Der kombinierte Niveauschalter als das vierte Ausführungsbeispiel des Niveauschalters nach der Erfin-

dung ist überall anwendbar. Der Oszillator in der Schaltung des Niveauschalters oszilliert, wenn die Sonde  $s_4$  in ein Material mit der elektrischen Leitfähigkeit von einem vernachlässigbaren Wert bis zu 1 S/cm und unabhängig von der Anhaftigkeit des Materials und davon, ob es flüssig, pulverig oder breiartig ist, eingetaucht ist. Daher funktioniert der kombinierte Niveauschalter sehr gut auch überall, wo herkömmliche kapazitive Niveauschalter versagen, wie z. B. bei einem feucht und dadurch auch elektrisch leitend gewordenen pulverigen Material versagen.

Der erfindungsgemäße Niveauschalter funktioniert also in allen Ausführungsbeispielen mit einer konstanten Spannungsamplitude an dem Ausgang des Oszillators, es ist aber die Oszillatorfrequenz, die sich ändert, wenn die Oberfläche des in dem Behälter enthaltenen Materiales unter das Niveau der Sonde  $s_j$  ( $j = 1, 2, 3$  oder 4) sinkt. Das Verhalten des Niveauschalters wird bei der Herstellung einfach durch die Kapazität des als Frequenzfilter funktionierenden und den Ausgang des Operationsverstärkers 1 mit dem Eingang des frequenz tiefen Bandfilters 7 verbindenden Kondensators 4 oder 5 eingestellt. Mit demselben erfindungsgemäßen Niveauschalter, d. h. elektronischer Schaltung und Sonde, beherrscht man alle in der Industrie oder anderswo technisch interessante Materialien.

#### Patentansprüche

1. Niveauschalter, dadurch gekennzeichnet, daß der nichtinvertierende Eingang eines Operationsverstärkers (1), bei dem die positive und die negative Rückkopplung durch einen Widerstand (21) beziehungsweise durch einen Widerstand (31) realisiert sind, über einen Widerstand (23) an den Elektrodeschaft ( $es$ ) einer Elektrode ( $e$ ) auf einer Sonde ( $s_1$ ) und der invertierende Eingang des Operationsverstärkers (1) über einen Kondensator (32) an Masse angeschlossen sind, daß eine an die Masse angeschlossene ringartige Gegenelektrode ( $oe$ ) ein Ende eines zylinderartigen dielektrischen Körpers ( $db$ ) der Sonde ( $s_1$ ) umgibt, dessen anderes Ende durch die Elektrode ( $e$ ) abgeschlossen ist, deren Elektrodeschaft ( $es$ ) den dielektrischen Körper ( $db$ ) axial durchdringt, und daß der Ausgang des Operationsverstärkers (1) über seriengeschaltete einen Kondensator (4), ein frequenz tiefes Bandfilter (7), einen Gleichrichter (8), einen Amplitudenbegrenzer (9) und einen Verstärker (10) an den Ausgang ( $o$ ) des Niveauschalters angeschlossen ist.
2. Niveauschalter, dadurch gekennzeichnet, daß der invertierende Eingang eines Operationsverstärkers (1), bei dem die positive und die negative Rückkopplung durch einen Widerstand (21) beziehungsweise durch einen Widerstand (31) realisiert sind, an eine Ringplatte ( $rp$ ) einer Sonde ( $s_2$ ) und der Ausgang des Operationsverstärkers (1) über den Kondensator (5) an Masse angeschlossen sind, daß eine an die Masse angeschlossene ringartige Gegenelektrode ( $oe$ ) ein Ende eines zylinderartigen dielektrischen Körpers ( $db$ ) der Sonde ( $s_1$ ) umgibt und die Ringplatte ( $rp$ ) nahe an dessen anderem Ende in den dielektrischen Körper ( $db$ ) koaxial eingebaut ist und daß der Ausgang des Operationsverstärkers (1) über seriengeschaltete ein frequenz tiefes Bandfilter (7), einen Gleichrichter (8), einen Amplitudenbe-

grenzer (9) und einen Verstärker (10) an den Ausgang (o) des Niveauschalters angeschlossen ist.

3. Niveauschalter, dadurch gekennzeichnet, daß der invertierende Eingang eines Operationsverstärkers (1), bei dem die positive und die negative Rückkopplung durch einen Widerstand (21) beziehungsweise durch einen Widerstand (31) realisiert sind, an eine Ringplatte (rp) einer Sonde (s<sub>3</sub>) und der Ausgang des Operationsverstärkers (1) über den Kondensator (5) an Masse angeschlossen sind,

daß eine an Masse angeschlossene ringartige Gegenelektrode (oe) ein Ende eines zylinderartigen dielektrischen Körpers (db) der Sonde (s<sub>3</sub>) umgibt und die Ringplatte (rp) nahe an dessen anderem Ende in den dielektrischen Körper (db) koaxial eingebaut ist und eine am Umfang des dielektrischen Körpers (db) zwischen der Gegenelektrode (oe) und der Ringplatte (rp) angeordnete Schirmelektrode (se) über einen Kondensator (6) an den Ausgang des Operationsverstärkers (1) angeschlossen ist

und daß der Ausgang des Operationsverstärkers (1) über seriengeschaltete ein frequenziefes Bandfilter (7), einen Gleichrichter (8), einen Amplitudenbegrenzer (9) und einen Verstärker (10) an den Ausgang (o) des Niveauschalters angeschlossen ist.

4. Niveauschalter, dadurch gekennzeichnet, daß der invertierende Eingang eines Operationsverstärkers (1), bei dem die positive und die negative Rückkopplung durch einen Widerstand (21) beziehungsweise durch einen Widerstand (31) realisiert sind, an eine Ringplatte (rp) einer Sonde (s<sub>4</sub>) und der nichtinvertierende Eingang des Operationsverstärkers (1) über seriengeschaltete Widerstände (23, 24) an einen Schaft (es) einer Elektrode (e) an der Sonde (s<sub>4</sub>) und der Ausgang des Operationsverstärkers (1) über den Kondensator (5) an Masse angeschlossen sind,

daß eine an Erde (ec) des elektrischen Netzes und über ein aus parallelgeschalteten Widerstand (111) und Kondensator (112) zusammengesetztes Filter (11) an Masse der Schaltung angeschlossene ringartige Gegenelektrode (oe) ein Ende eines zylinderartigen dielektrischen Körpers (db) der Sonde (s<sub>4</sub>) umgibt und die Ringplatte (rp) nahe an dessen anderem Ende in den dielektrischen Körper (db) koaxial eingebaut ist und eine am Umfang des dielektrischen Körpers (db) zwischen der Gegenelektrode (oe) und der Ringplatte (rp) angeordnete Schirmelektrode (se) über einen Kondensator (6) an den Ausgang des Operationsverstärkers (1) angeschlossen ist und das andere Ende des dielektrischen Körpers (db) durch die Elektrode (e) abgeschlossen ist, deren Elektrodeschaft (es) den dielektrischen Körper (db) axial durchdringt,

und daß der Ausgang des Operationsverstärkers (1) über seriengeschaltete ein frequenziefes Bandfilter (7), einen Gleichrichter (8), einen Amplitudenbegrenzer (9) und einen Verstärker (10) an den Ausgang (o) des Niveauschalters angeschlossen ist.

5. Niveauschalter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Ausgang des Operationsverstärkers (1) über einen Widerstand (25) und einen dazu parallelgeschalteten regelbaren Widerstand (251) an die gemeinsame Klemme der Widerstände (23, 24) angeschlossen ist.

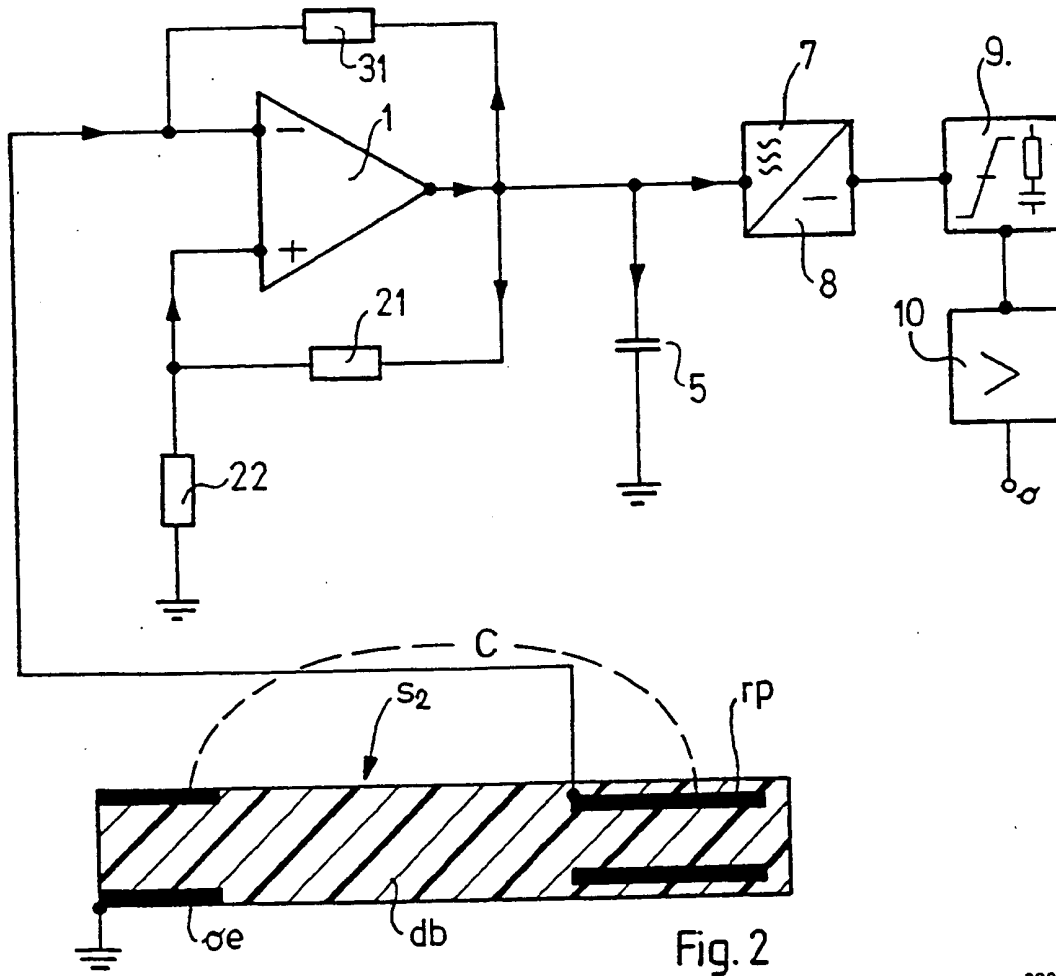
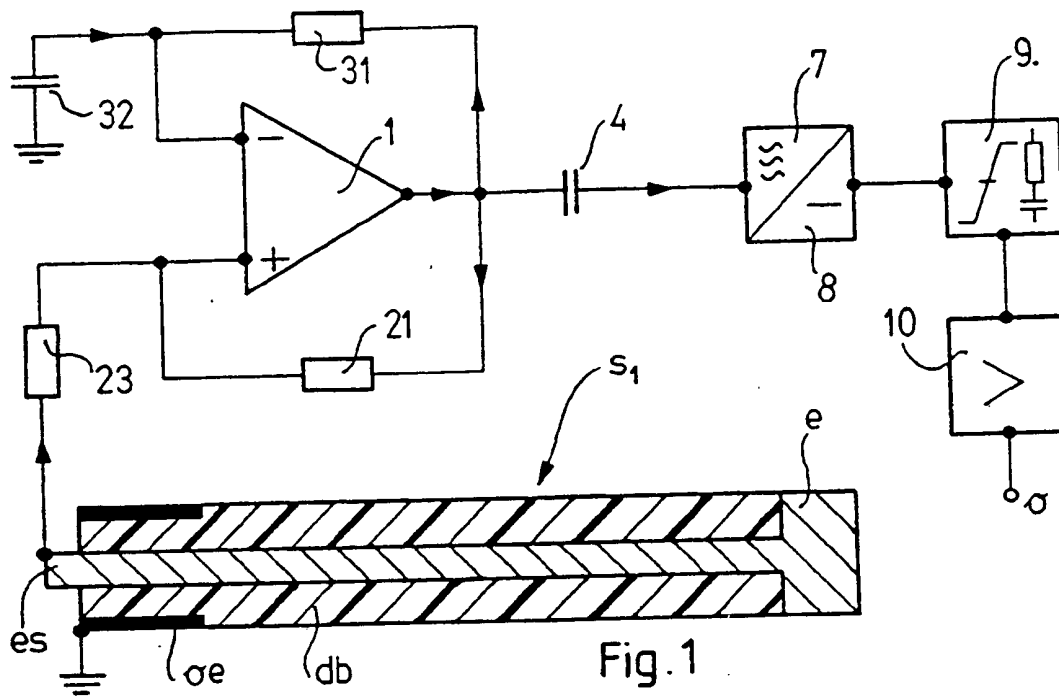
6. Niveauschalter nach einem der Ansprüche 2, 3, 4

oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein an Masse angeschlossener Widerstand (22) mit seiner anderen Klemme an den nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers (1) angeschlossen ist.

---

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

---





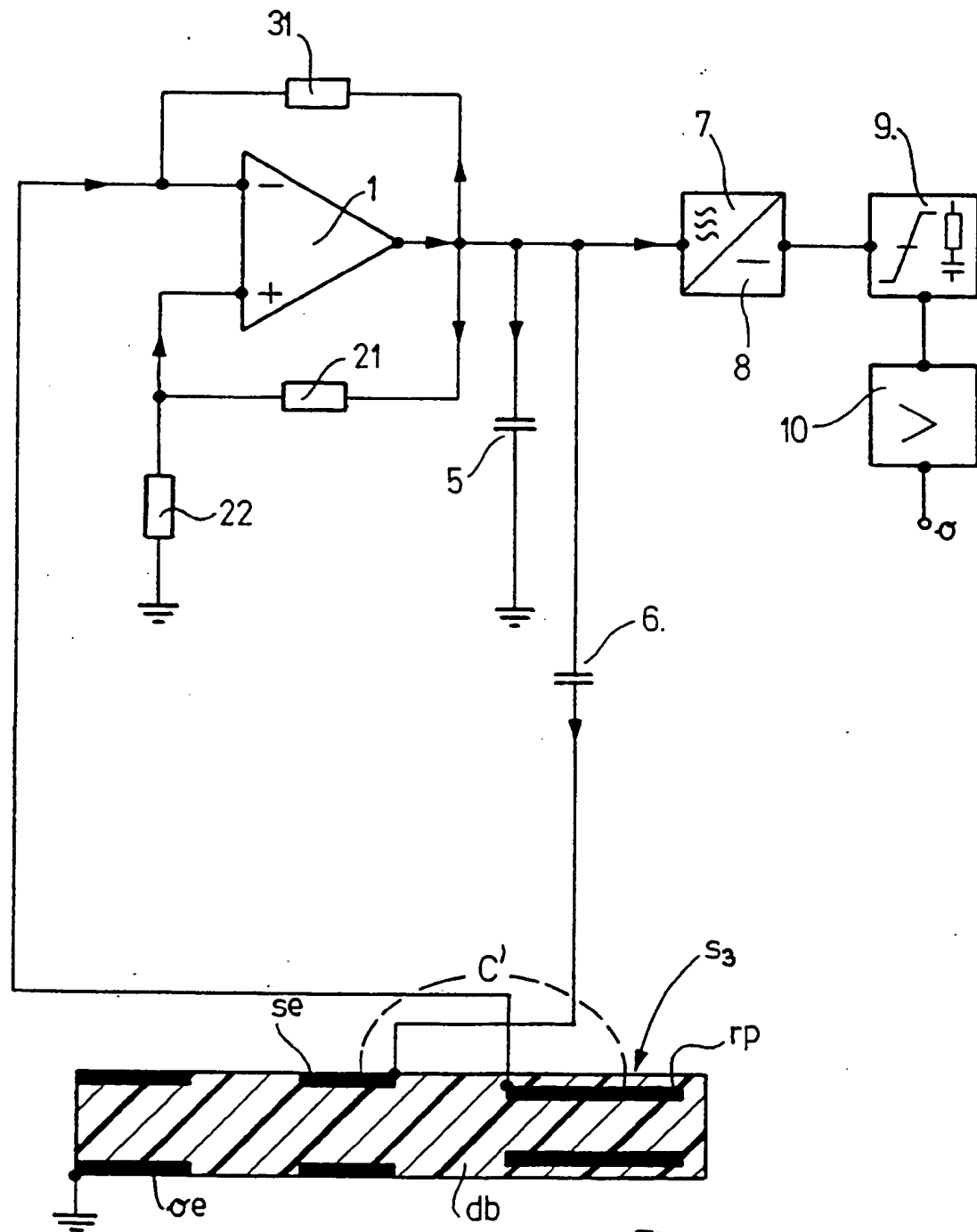


Fig. 3

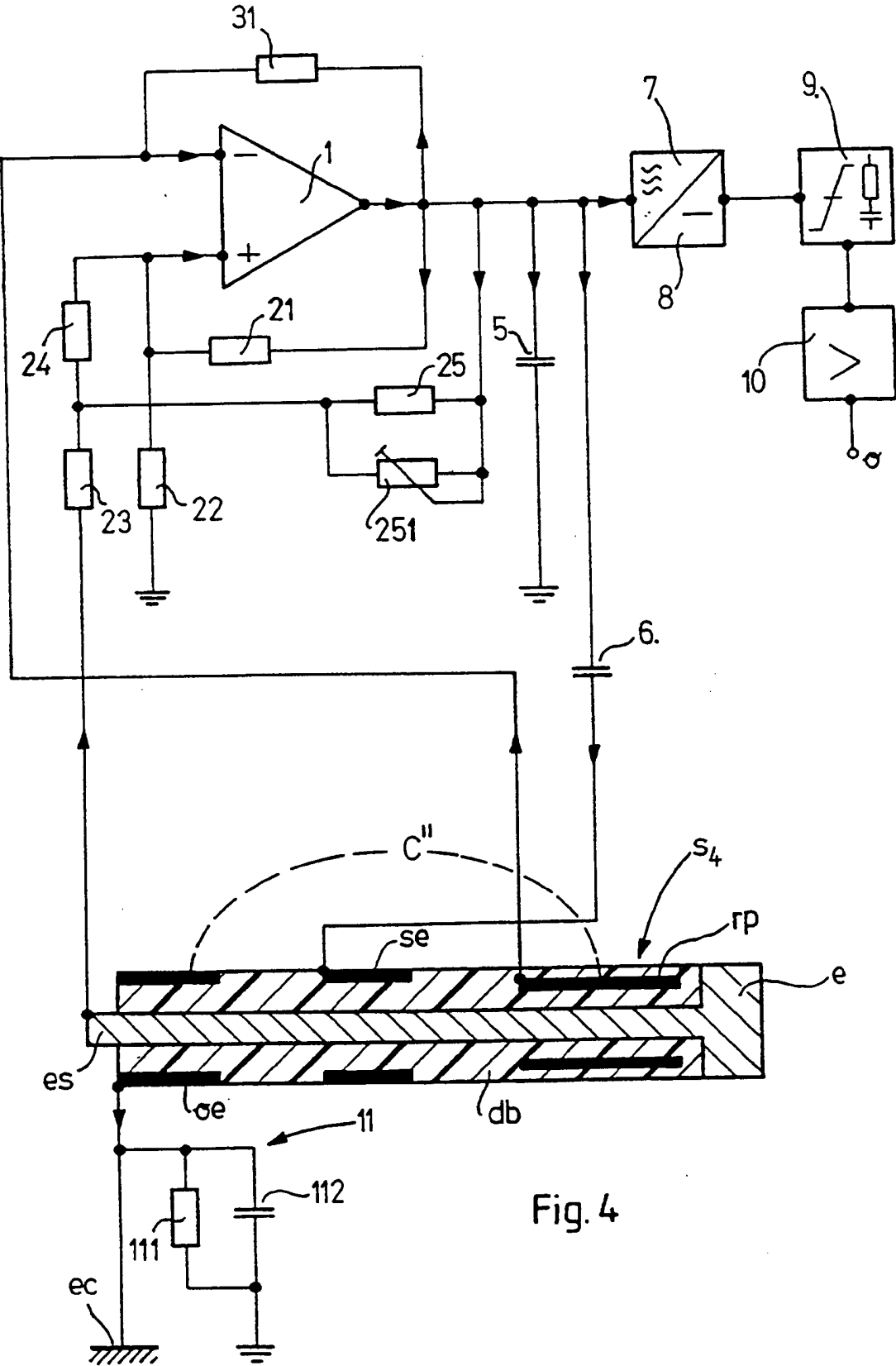


Fig. 4

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**